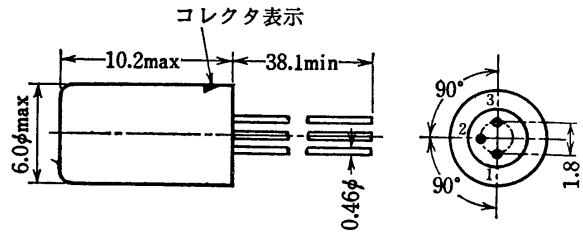


2SA12

ゲルマニウム PNP 合金接合形
A M 中間周波増幅用



1. エミッタ 2. ベース 3. コレクタ

■ 最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-16 V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-0.5 V
コレクタ電流	I_C	-15 mA
エミッタ電流	I_E	15 mA
許容コレクタ損失	P_Q	80mW
接合部温度	T_j	85 °C
保存温度	T_{stg}	-55~+85 °C

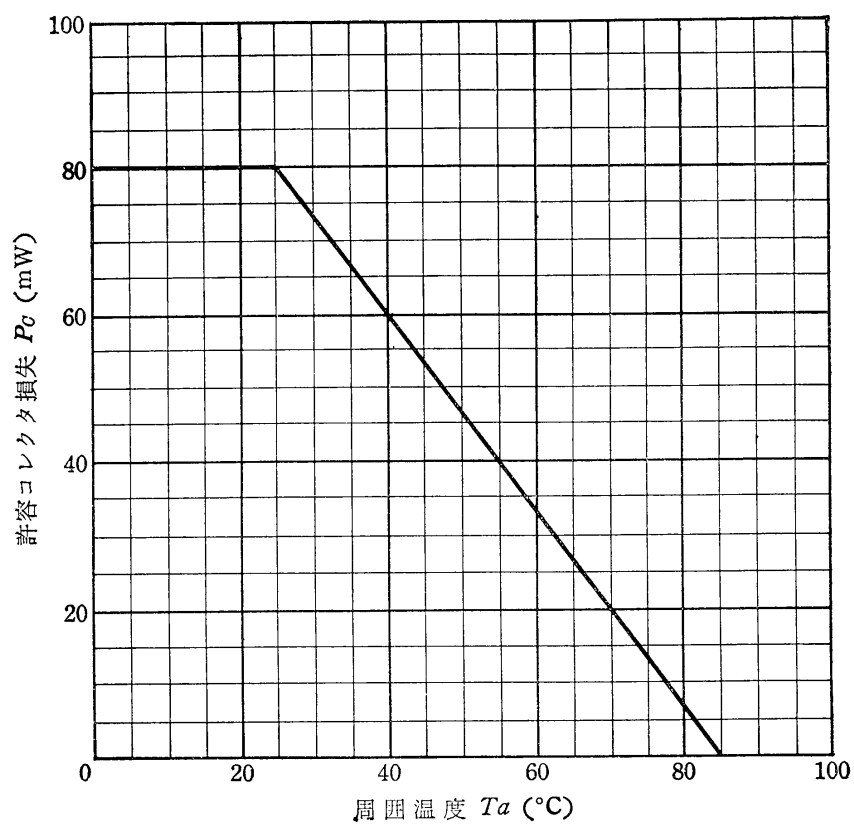
■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

		最小	標準	最大
コレクタ遮断電流	I_{CBO} ($V_{CB}=-12\text{V}, I_E=0$)	—	-1.5	-6.0 μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO} ($V_{EB}=-0.5\text{V}, I_C=0$)	—	—	-12 μA
小信号電流増幅率	h_{fe} ($V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}, f=270\text{c/s}$)	—	60	—
遮断周波数	f_{ab} ($V_{CB}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}$)	—	8	— Mc
入力インピーダンス抵抗分	$h_{ie(\text{real})}$ ($V_{CE}=-6\text{V}, I_E=1\text{mA}, f=50\text{Mc}$)	—	70	— Ω
コレクタ出力容量*	C_{ob} ($V_{CB}=-6\text{V}, I_C=0, f=1\text{Mc}$)	7	10	13 pF
入力コンダクタンス	g_{ie}	—	1.5	— m Υ
入力容量	C_{ie}	—	960	— pF
逆伝達アドミタンス	$ y_{re} $	—	25.6	— $\mu\Upsilon$
同位相角	$-\phi_{re}$	—	100.5	— °
順伝達アドミタンス	$ y_{fe} $	—	32.5	— m Υ
同位相角	$-\phi_{fe}$	—	16.5	— °
出力コンダクタンス	g_{oe}	—	30.5	— $\mu\Upsilon$
出力容量	C_{oe}	—	28.2	— pF
中間周波電力利得*	IFG ($V_{CC}=-9\text{V}, I_E=1\text{mA}, f=455\text{kc}, R_g=1\text{k}\Omega, R_L=30\text{k}\Omega$)	—	31	— dB

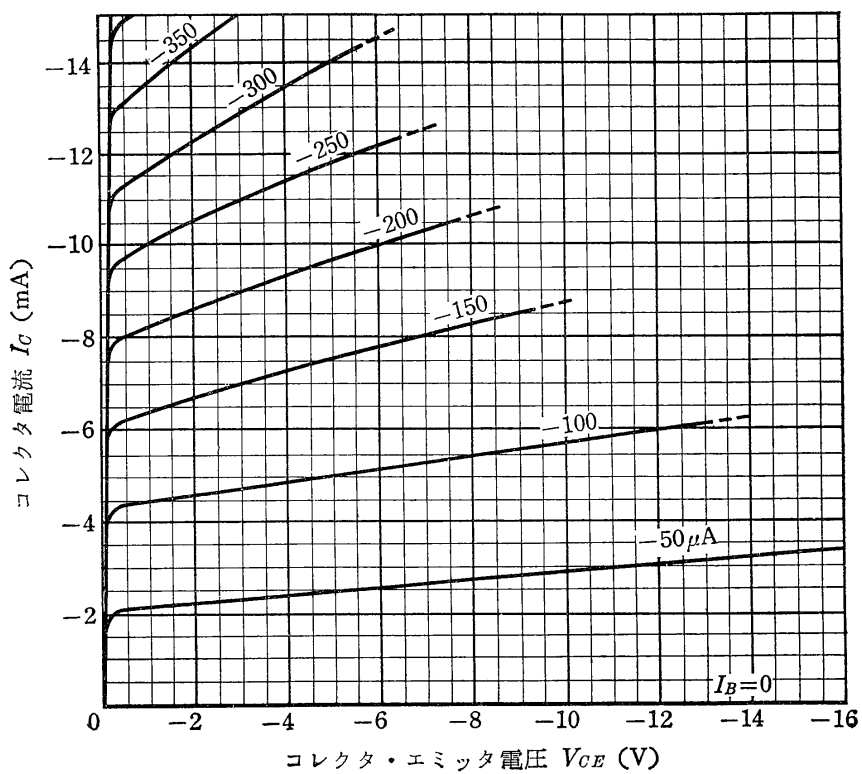
*2SA12 は C_{ob} および IFG の値により下記のように4区分し、現品にそれぞれ(A), (B), (C), (D)と表示してあります。

	(A)	(B)	(C)	(D)	
C_{ob}	7.0~10.5	9.5~13.0	7.0~10.5	9.5~13.0	(pF)
IFG	28~32	28~32	30~34	30~34	(dB)

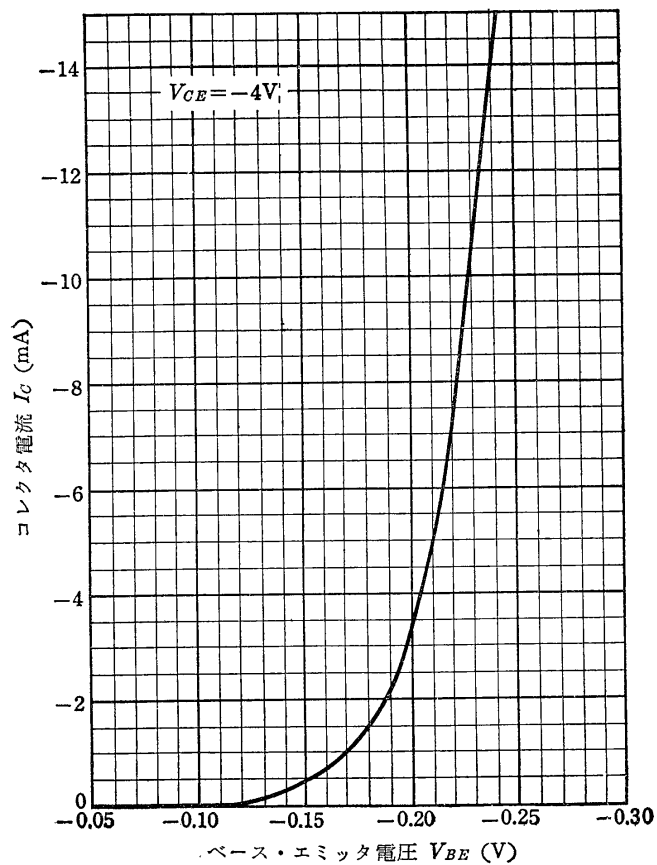
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



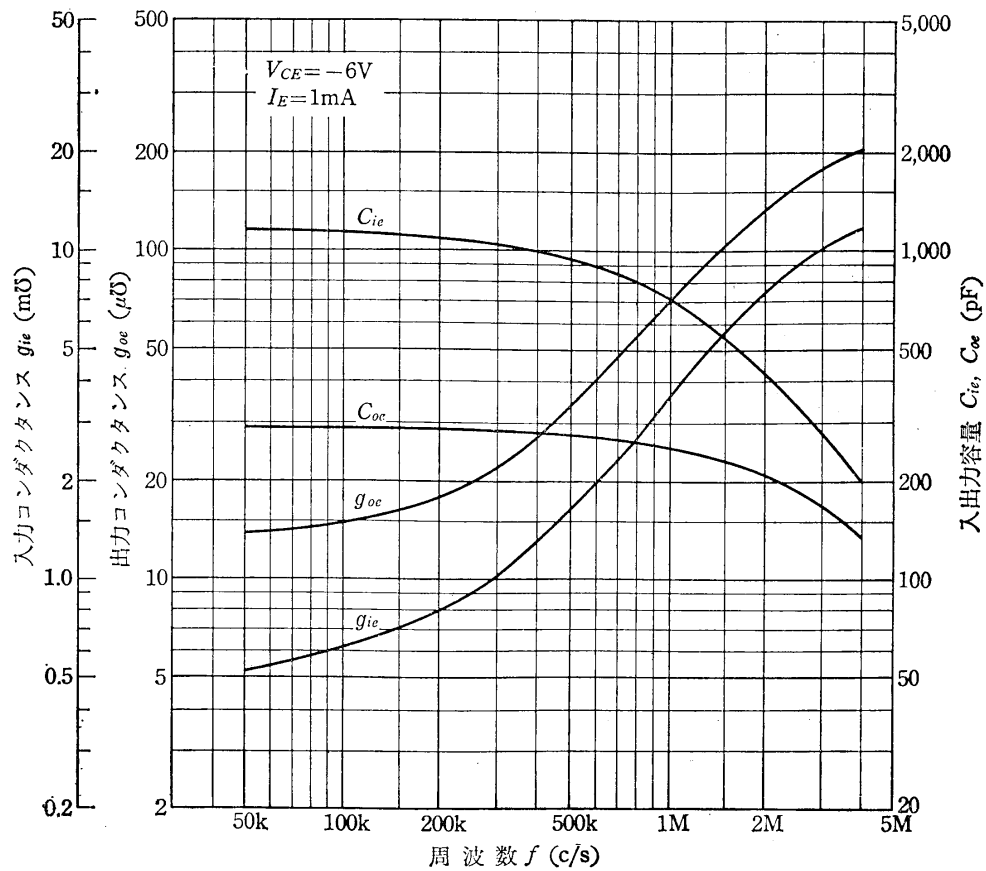
エミッタ接地出力静特性



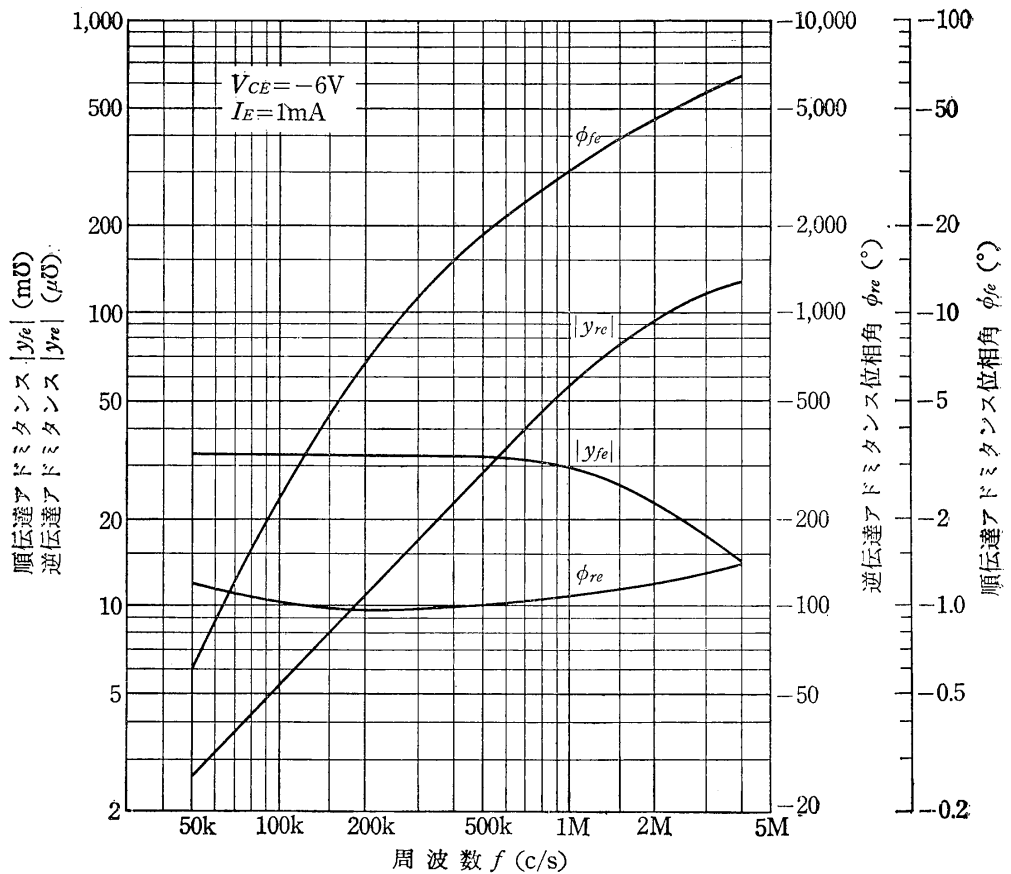
エミッタ接地伝達静特性



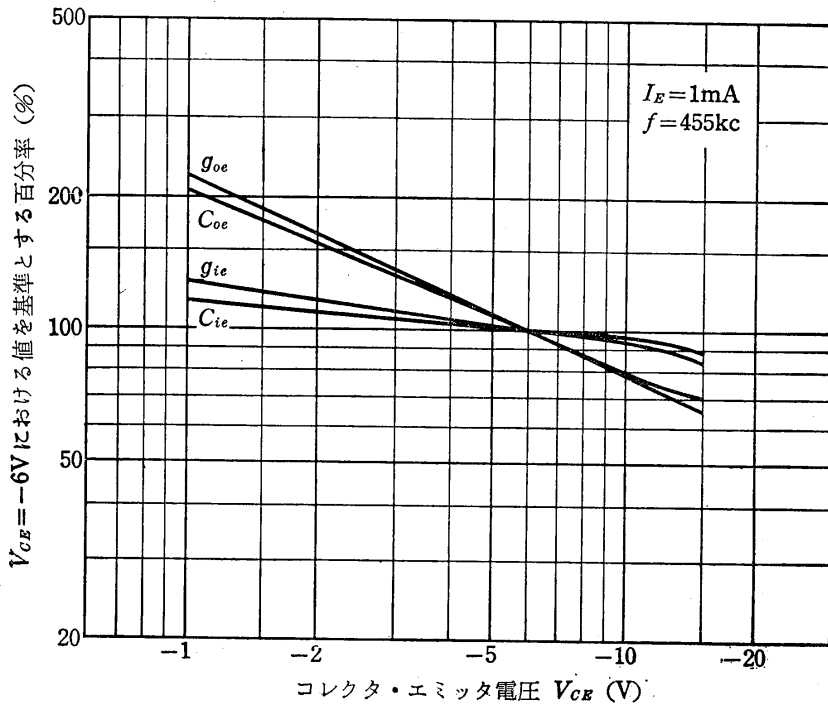
入出力アドミタンス対周波数特性



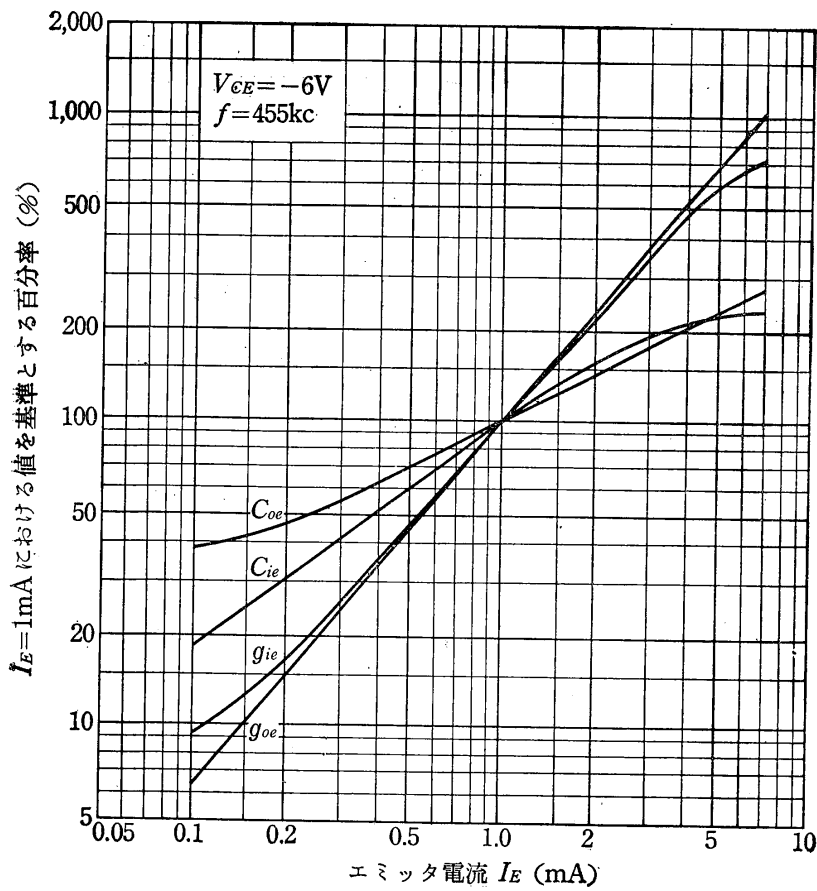
伝達アドミタンス対周波数特性



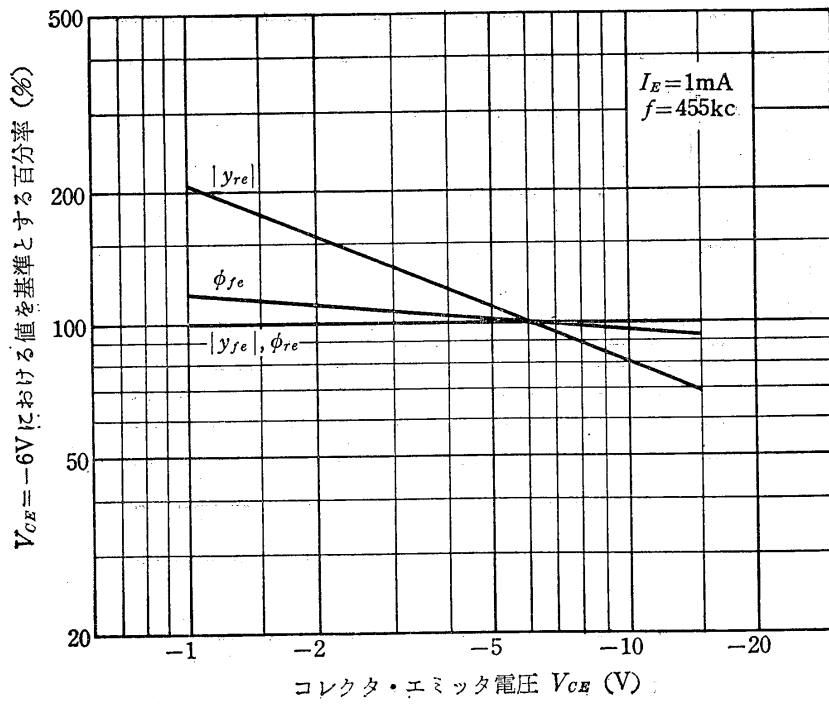
入出力アドミタンス対コレクタ・エミッタ電圧特性



入出力アドミタンス対エミッタ電流特性



伝達アドミタンス対コレクタ・エミッタ電圧特性



伝達アドミタンス対エミッタ電流特性

